

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
7. Oktober 2004 (07.10.2004) ✓

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/086576 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01S 5/183, 5/06

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/000333 ✓

(22) Internationales Anmeldedatum:  
23. Februar 2004 (23.02.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 13 609.6 26. März 2003 (26.03.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS  
GMBH [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regens-  
burg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ALBRECHT, Tony  
[DE/DE]; Erich-Kästner-Strasse 21, 93077 Bad Abbach  
(DE). BRICK, Peter [DE/DE]; Dechbetteger Strasse 26,  
93049 Regensburg (DE). PHILIPPENS, Marc [NL/DE];  
Hermann-Köhl-Strasse 30a, 93049 Regensburg (DE).  
PLAINE, Glenn-Yves [FR/DE]; Spiegelgasse 6, 93047  
Regensburg (DE).

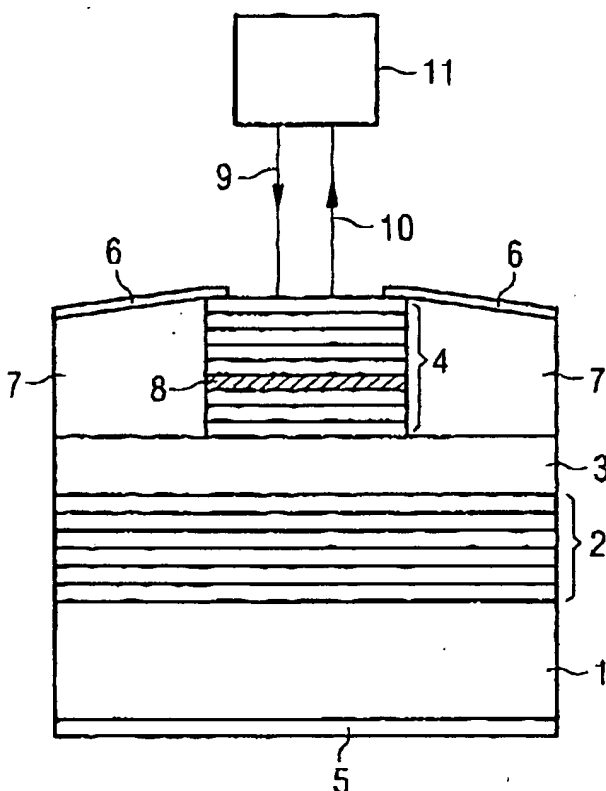
(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATEN-  
TANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Rüdlerstrasse 55,  
80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SEMICONDUCTOR LASER SHOWING REDUCED SENSITIVITY TO DISTURBANCES

(54) Bezeichnung: HALBLEITERLASER MIT REDUZierter RÜCKWIRKUNGSEMPFINDLICHKEIT ✓



(57) Abstract: Disclosed is a semiconductor laser, especially a single-mode laser, comprising at least one absorbing layer (8) in the laser resonator thereof, said absorbing layer (8) reducing transmission  $T_{\text{res}}$  of the laser beam (10) in the laser resonator so as to decrease sensitivity of the semiconductor laser to disturbances created by radiation (9) that is fed back into the laser resonator, whereby variations of the output power due to radiation (9) feedback are diminished.

(57) Zusammenfassung: Ein Erfindungsgemässer Halbleiterlaser, insbesondere ein Einmoden-Laser, enthält in seinem Laserresonator mindestens eine absorbierende Schicht (8), welche die Transmission  $T_{\text{res}}$  der Laserstrahlung (10) im Laserresonator zur Verringerung der Rückwirkungsempfindlichkeit des Halbleiterlasers für in den Laserresonator rückgekoppelte Strahlung (9) reduziert. Dadurch werden Schwankungen der Ausgangsleistung durch rückgekoppelte Strahlung (9) reduziert.

WO 2004/086576 A1